

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им.

А.Ф. Иоффе Российской академии наук

объявляет конкурс на замещение вакантной должности

ведущего научного сотрудника, кандидата наук

лаборатории полупроводниковой люминесценции и инжекционных излучателей

Вакансия VAC 105382

Тематика исследований

Физика, оптика и технология изготовления приборов нанофотоники.

Трудовая деятельность

Научное руководство группой фотоники наноструктур, включая:

- определение новых направлений исследований в областях физики и оптики полупроводников, разработки конструкции и технологии создания элементов нанофотоники на основе полупроводниковых гетероструктур;
- развитие метода травления сфокусированным ионным пучком для применения в прямой нанолитографии;
- разработка методик исследования воздействия ионного пучка на формирование дефектов в полупроводниковых гетероструктурах при ионно-лучевой литографии;
- разработка технологических подходов для формирования сфокусированным ионным пучком устройств нанофотоники на основе полупроводниковых гетероструктур
- разработка методик исследования характеристик пассивных (фотонные кристаллы, частотные фильтры, делители и пр.) и активных (лазеры с кольцевыми, фотонно-кристаллическими резонаторами, насыщающимися поглотителями и пр.) элементов интегральной нанофотоники;
- постановка задач и научное сопровождение процессов моделирования режимов работы элементов и устройств интегральной нанофотоники,
- подготовка и публикация научных статей, обзоров, выступления на конференциях, рецензирование журнальных статей по специальности, руководство магистрами и аспирантами.

Требования к претенденту

- кандидат физико-математических наук по специальности 01.04.10 – физика полупроводников;
- опыт научной деятельности: не менее 30 лет.
- наукометрические показатели: индексы Хирша по WoS и Scopus DB – 12 и выше;
- наличие не менее 30 публикаций в рецензируемых научных изданиях (в т.ч. не менее 4 в изданиях первого и второго квартилей WoS/Scopus) и конференционных сборниках за последние 5 лет, участие с докладами на российских и международных конференциях, участие в НИР по проектам российских фондов, хозяйственным договорам и программам министерств и ведомств РФ (не менее 5 за последние 5 лет);
- опыт разработки методик исследования и характеристик инжекционных и квантово-каскадных лазеров;
- опыт разработки технологии прямой литографии сфокусированным ионным пучком;
- опыт разработки технологических подходов для формирования сфокусированным ионным пучком устройств нанофотоники на основе полупроводниковых гетероструктур;
- опыт работы по программам РФ и проектам, реализуемым по грантам Минобрнауки. Практика руководства научно-исследовательскими проектами и проектами РФ;
- педагогическая практика: руководство студентами и магистрами по программам высшего образования, чтение лекции и сопровождение практических занятий. Руководство аспирантами

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 36 837 руб.

СТАВКА: 1.0

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 15 000 руб.

Срок трудового договора – 5 лет

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45